

用途:主要用于显示屏驱动。

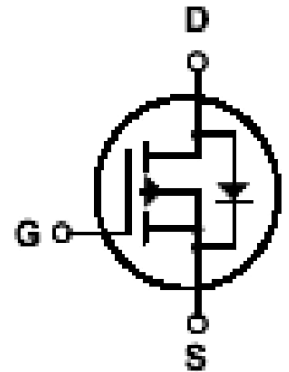
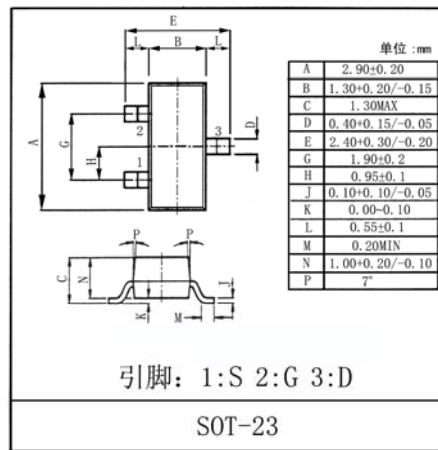
Purpose: Primarily the display screen drive applications.

特点: 沟道场效应管, MOS 晶体管。

Features: trench FET Power MOSFET 100% Rg Tested.

极限参数/Absolute maximum ratings ($T_a=25^\circ\text{C}$)

参数符号 Symbol	数值 Rating	单位 Unit
V_{DSS}	-20	V
V_{GSS}	± 8	V
$I_D (T_A=25^\circ\text{C})$	-2.8	A
$I_D (T_A=70^\circ\text{C})$	-1.5	A
I_{DM}	-10	A
I_S	-1.6	A
$P_D (T_A=25^\circ\text{C})$	1.25	W
$P_D (T_A=70^\circ\text{C})$	0.8	W
T_{stg}	-55~150	$^\circ\text{C}$



电性能参数/Electrical characteristics ($T_a=25^\circ\text{C}$)

参数符号 Symbol	测试条件 Test condition	数值 Rating			单位 Unit
		最小值 Min	典型值 Typ	最大值 Max	
$V_{(BR)DSS}$	$V_{GS}=0V$ $I_D=-250\mu A$	-20			V
$V_{GS(th)}$	$V_{DS}=V_{GS}$ $I_D=-250\mu A$	-0.45		-0.95	V
$R_{DS(on)1}$	$V_{GS}=-4.5V$ $I_D=-2.8A$		0.105	0.13	Ω
$R_{DS(on)2}$	$V_{GS}=-2.5V$ $I_D=-2A$		0.145	0.19	Ω
$I_{DSS(1)}$	$V_{DS}=-20V$ $V_{GS}=0V$			-1	μA
$I_{DSS(2)}$	$V_{DS}=-20V$ $V_{GS}=0V$ $T_j=55^\circ\text{C}$			-10	μA
I_{GSS}	$V_{GS}=\pm 8V$ $V_{DS}=0V$			± 0.1	μA
$I_{D(1)}$	$V_{DS}\leq -5V$ $V_{GS}=-4.5V$	-6			A
$I_{D(2)}$	$V_{DS}\leq -5V$ $V_{GS}=-2.5V$	-3			A
V_{SD}	$I_S=-1.6A$ $V_{GS}=0V$		-0.8	-1.2	V
g_{FS}	$V_{DS}=-5V$ $I_D=-2.8A$		6.5		S
C_{iss}	$V_{DS}=-6V$ $V_{GS}=0$ $f=1\text{MHz}$		415		pF
C_{oss}			223		
C_{rss}			84		
$t_{d(on)}$	$V_{DD}=-6V$ $R_L=6\Omega$ $I_D\approx -1A$ $V_{GEN}=-4.5V$ $R_G=6\Omega$		13	25	ns
t_r			36	60	
$t_{d(off)}$			42	70	
t_f			34	60	

印章/Marking: A1H

